



博学而笃志 切问而近思

站内搜索: [搜索](#)

蒋玉龙

系别: 微电子学系
职称: 教授 博导
职务:
办公
室:
电话: 65643768
E-mail: yljiang@fudan.edu.cn
主页: <http://homepage.fudan.edu.cn/~yljiang>

教育背景

- 9/1/1995至7/1/1999 复旦大学 本科学士
- 7/1/1999至7/1/2002 复旦大学 硕士研究生
- 9/1/2002至7/1/2005 复旦大学 博士研究生

研究方向

纳米CMOS器件源、漏、栅金属化工程、新型纳米电子器件和工艺

课程教学

本科课程: 半导体物理 《半导体器件原理》

学术兼职

- 第三届 (INEC-2010) IEEE纳米电子学会议 信息主席
- 第九届 (IWJT-2009) 国际结技术会议执行委员会主席

科研项目

- 教育部霍英东教育基金会第11届高校青年教师优选资助课题: 下一代 (65nm以下) 金属 (硅化物) 栅技术的研究, 负责人
- 2007年度上海市青年科技启明星 (A类) 计划: 纳米CMOS器件中新型镍合金全硅化物金属栅材料 and 工艺研究, 负责人

论文著作

1. J. Electron. Material, The reaction characteristics of ultra thin Ni film on undoped and doped Si (100), , , 770-773
2. Appl. Phys. Lett, Nickel silicidation on n and p-type junctions at 300oC, , , 410-412
3. J. Appl. Phys, Ni/Si solid phase reaction studied by temperature-dependent current-voltage technique, , , 866-870
4. Appl. Surf. Sci, Study of Ni/Si(1 0 0) solid-state reaction with Al addition, , , 5631-5634
5. Microelectron. Eng, Study of Ni/Si(100) solid-state reaction with Y addition, , , 2013-2015
6. J. Electron. Material, Paul K Chu, Silicidation of Ni(Yb) Film on Si(001), , , 245-248
7. J. Appl. Phys., 101, 053705(2007). , Schottky contact barrier height extraction by admittance measurement, , ,
8. J. Mater. Res, Linear growth of Ni₂Si thin film on n+/p junction at low temperature, , , 3017-3021
9. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B, Nickel silicide formation on shallow junctions, , , 160-166
10. Electron. Lett, Ramp rate dependence of NiSi formation studied by the silicided Schottky contact, , , 103-104
11. J. Appl. Phys., 102, 033508(2007), Growth of Pinhole Free Ytterbium Silicide Film by Solid-State Reaction on Si(001) with a Thin Amorphous Si Interlayer, , ,
12. J. Vac. Sci. Technol. A, Oxidation suppression in ytterbium silicidation by Ti/TiN bi-capping layer, , , 285-289
13. J. Electron. Material, Wayne Holland, Arsenic redistribution induced by low temperature Ni silicidation at 450oC on shallow junctions, , , 937-940
14. Semicond. Sci. Technol. 20, Electrical characterization of NiSi/Si interfaces formed by a single and a two-step rapid thermal silicidation, , , 716-719
15. Extended Abstracts of the 7th International Workshop on Junction Technology (IWJT2007), Kyoto, Japan, Oxidation Suppression for YbSi_{2-x} Formation and New Method to Extract Schottky Barrier Height by Admittance Measurement, , , 93-98
16. 第十四届全国半导体集成电路、硅材料学术年会论文集，下册（半导体学报，27，增刊，385-388（2006）），非晶化注入技术在NiSi SALICIDE工艺中的应用研究，，，11-14

获奖情况

《半导体物理》课程被评为2008年度复旦大学精品课程和上海市教委重点立项课程

[返回](#)